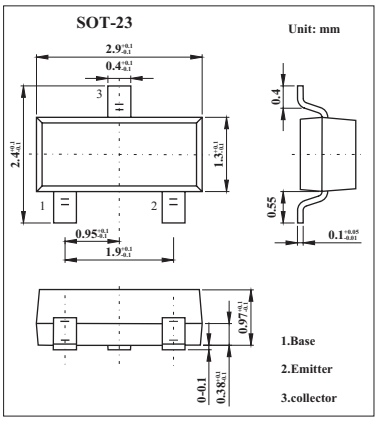
TY Semicondutor®

**Product specification**

# 2PD601A




## ■ Features

- Low current (max. 100 mA)
- Low voltage (max. 50 V).

## ■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃

| Parameter | Symbol | Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Collector-base voltage | $V_{CBO}$ | 60 | V |
| Collector-emitter voltage | $V_{CEO}$ | 50 | V |
| Emitter-base voltage | $V_{EBO}$ | 6 | V |
| Collector current (DC) | $I_C$ | 100 | mA |
| Peak collector current | $I_{CM}$ | 200 | mA |
| Peak base current | $I_{BM}$ | 100 | mA |
| Total power dissipation Tamb≤25℃; * | $P_{tot}$ | 250 | mW |
| Storage temperature | $T_{stg}$ | -65 to +150 | ℃ |
| Junction temperature | $T_j$ | 150 | ℃ |
| Operating ambient temperature | $T_{amb}$ | -65 to +150 | ℃ |
| Thermal resistance from junction to ambient * | $R_{th\ j\text{-}a}$ | 500 | K/W |

* Transistor mounted on an FR4 printed-circuit board.

# 2PD601A

## ■ Electrical Characteristics Ta = 25℃

| Parameter | | Symbol | Testconditons | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collector cut-off current | | $I_{CBO}$ | $I_E$ = 0; $V_{CB}$ = 60 V | | | 10 | nA |
| | | | $I_E$ = 0; $V_{CB}$ = 60 V; $T_j$ = 150℃ | | | 5 | μA |
| Emitter cut-off current | | $I_{EBO}$ | $I_C$ = 0; $V_{EB}$ = 5 V | | | 10 | nA |
| DC current gain | 2PD601AQ | $h_{FE}$ | $I_C$ = 2 mA; $V_{CE}$ = 10 V; * | 160 | | 260 | |
| | 2PD601AR | | | 210 | | 340 | |
| | 2PD601AS | | | 290 | | 460 | |
| DC current gain | | $h_{FE}$ | $I_C$ = 100 mA; $V_{CE}$ = 2 V; | 90 | | | |
| Collector-emitter saturation voltage | | $V_{CEsat}$ | $I_C$ = 100 mA; $I_B$ = 10 mA; * | | | 500 | mV |
| Collector capacitance | | $C_c$ | $I_E$ = ie = 0; $V_{CB}$ = 10 V; f = 1 MHz | | | 3.5 | pF |
| Transition frequency | 2PD601AQ | $f_T$ | $I_C$ = 2 mA; $V_{CE}$ = 10 V; f = 100 MHz * | 100 | | | MHz |
| | 2PD601AR | | | 120 | | | |
| | 2PD601AS | | | 140 | | | |

* Pulse test: tp≤300 μs; δ≤0.02.

## ■Marking

| Type Number | 2PD601AQ | 2PD601AR | 2PD601AS |
|---|---|---|---|
| Marking | ZQ | ZR | ZS |

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9